

New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

20 STERN AVE.
SPRINGFIELD, NEW JERSEY 07081
U.S.A.

TELEPHONE: (201) 376-2922
(212) 227-6005
TELEX: 13-8720

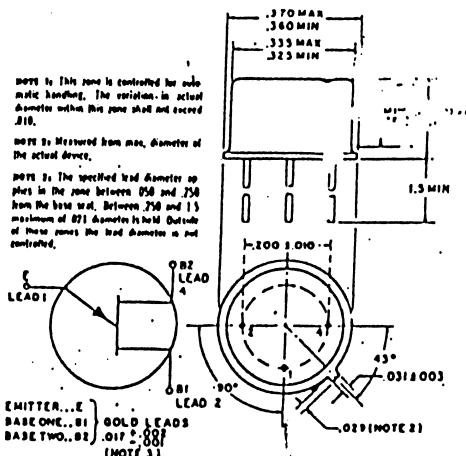
2N1671,1A,B,C

The 2N1671 is intended for general purpose industrial applications where circuit economy is of primary importance. The 2N1671A is intended for industrial use in firing circuits for Silicon Controlled Rectifiers and other applications where a guaranteed minimum pulse amplitude is required. The 2N1671C is intended for applications where a low emitter leakage current and a low peak emitter current (trigger current) are required.

These transistors feature Fixed-Bed Construction and are hermetically sealed in a welded case. All leads are electrically isolated from the case.

absolute maximum ratings (25°C)

RMS Power Dissipation	450 mW ¹
RMS Emitter Current	50 mA
Peak Emitter Current ²	2 amperes
Emitter Reverse Voltage	30 volts
Interbase Voltage	35 volts
Operating Temperature Range	-65°C to +140°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C



electrical characteristics (25°C)

PARAMETER	SYMBOL	MIN. MAX.	MIN. MAX.	MIN. MAX.	MIN. MAX.
Intrinsic Standoff Ratio ($V_{BB} = 10V$) (Note 3)	η	0.47 0.62	0.47 0.62	0.47 0.62	0.47 0.62
Interbase Resistance ($V_{BB} = 3V$, $I_E = 0$) (Note 4)	R_{BB}	4.7 9.1	4.7 0.1	4.7 0.1	4.7 0.1
Emitter Saturation Voltage ($V_{BB} = 10V$, $I_E = 50mA$)	$V_{E(SAT)}$	5	5	5	5
Modulated Interbase Current ($V_{BB} = 10V$, $I_E = 50mA$)	$I_{BB(MOD)}$	6.8 22	6.8 22	6.8 22	6.8 22
Emitter Reverse Current ($V_{BB} = 30V$, $I_E = 0$) (Fig. 6)	I_{ER}	12	12	0.2	0.2
Peak Point Emitter Current ($V_{BB} = 25V$) (Fig. 8)	I_P	25	25	6	6
Valley Point Current ($V_{BB} = 20V$, $R_{BB} = 100\Omega$) (Fig. 9)	I_V	8	8	8	8
Base-One Peak Pulse Voltage (Note 5)	V_{BO1}		3.0	3.0	3.0
Emitter Reverse Current ($V_{BB} = 25V$, $V_{ER} = V_B - .3V$) (Fig. 8)	I_{ER}				

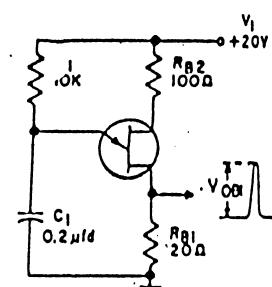
NOTES:

- (1) Derate 3.9 MW/°C increase in ambient temperature (Thermal resistance to case = 0.16°C/MW.)
- (2) Capacitor discharge—10μfd or less, 30 volts or less—Total interbase power dissipation must be limited by external circuitry.
- (3) The intrinsic standoff ratio, η , is essentially constant with temperature and interbase voltage. η is defined by the equation:

- (4) The interbase resistance is nearly ohmic and increases with temperature in a well defined manner as shown in figures 10 and 11. The temperature coefficient at 25°C is approximately 0.8%/°C.
- (5) The base-one peak pulse voltage is measured in the circuit below. This specification on the 2N1671A is used to ensure a minimum pulse amplitude for applications in SCR firing circuits and other types of pulse circuits. The variation of pulse amplitude with temperature and circuit parameters is shown in figures 12 to 15.



Quality Semi-Conductors





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.